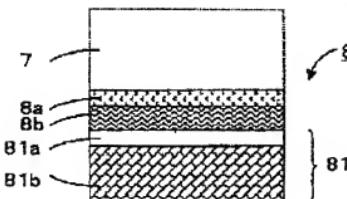


GALLIUM NITRIDE COMPOUND SEMICONDUCTOR LIGHT EMITTING ELEMENT

Publication number: JP2000294837
 Publication date: 2000-10-20
 Inventor: SATO HIROYUKI; MIYAWAKI MAKOTO
 Applicant: STANLEY ELECTRIC CO LTD
 Classification:
 - International: H01L33/00; H01S5/343; H01L33/00; H01S5/00; (IPC1-7): H01L33/00; H01S5/343
 - European:
 Application number: JP19990097154 19990405
 Priority number(s): JP19990097154 19990405

[Report a data error here](#)
Abstract of JP2000294837

PROBLEM TO BE SOLVED: To increase the reflection factor of a (p) electrode, and to increase the efficiency of external taking out of a p-type gallium nitride compound semiconductor element, by causing an Ag metal electrode and/or a Pt metal electrode to bring a (p) electrode into contact with a p-type gallium nitride compound semiconductor layer through an Ni metal region of a specific thickness. **SOLUTION:** When an Ag metal electrode 8b and a p-type gallium nitride compound semiconductor 7 are brought into contact through an Ni metal region 8a of a thickness <>100 angstrom as a (p) electrode 8, sharp, about 70.9%, reflection factor increase is obtained at the emission peak wavelength 470 nm of a gallium nitride semiconductor light emitting element. Besides, the semiconductor light emitting element fitted with the (p) electrode 8 is capable of producing an emission output about three time as high as that of an element using an Ni-Au electrode. In this way, the (p) electrode of a flip chip type gallium nitride semiconductor light emitting element is made into an electrode which satisfies an excellent ohmic characteristic and a high reflection factor, and increase of light extracting efficiency becomes feasible.



Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

(19) 日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報 (A)

(11) 特許出願公開番号

特開2000-294837

(P2000-294837A)

(43) 公開日 平成12年10月20日 (2000.10.20)

(51) Int.Cl.¹
H 01 L 33/00
H 01 S 5/343

識別記号

F I
H 01 L 33/00
H 01 S 3/18

テ-ロ-ト(参考)
N 5 F 0 4 1
6 7 7 5 F 0 7 3

審査請求 未請求 請求項の数4 O L (全7頁)

(21) 出願番号 特願平11-97154

(71) 出願人 000002303

(22) 出願日 平成11年4月5日 (1999.4.5)

スタンレー電気株式会社
東京都目黒区中目黒2丁目9番13号

(72) 発明者 佐藤 弘之

神奈川県横浜市青葉区荏田西1-3-1
スタンレー電気株式会社技術研究所内

(72) 発明者 宮脇 誠

神奈川県横浜市青葉区荏田西1-3-1
スタンレー電気株式会社技術研究所内

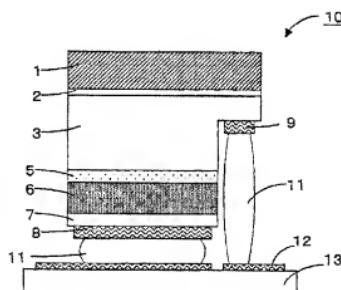
最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 窒化ガリウム系化合物半導体発光素子

(57) 【要約】

【課題】 本発明は、オーミック接觸が得られると共に、高い反射率特性が得られるようにしたフリップチップタイプの窒化ガリウム系化合物半導体素子のp電極および該電極を用いた発光素子を提供することを目的とする。

【解決手段】 透光性基板上にp型層が表面側となるようにして窒化ガリウム系化合物半導体をエピタキシャル成長したフリップチップタイプ素子のp電極であって、前記p電極をA g及び/またはP tの金属電極が100オングストローム以下の厚みのN i金属領域を介してp型窒化ガリウム系化合物半導体層と接觸し、且つ、前記半導体の発光ピーク波長における反射率が3.0%以上とする。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 透光性基板上にp型層が表面側となるようにして窒化ガリウム系化合物半導体をエビタキシャル成長し、該半導体の前記p型層側にp電極とn電極を記設して透光性基板側から光を取出すフリップチップタイプの窒化ガリウム系化合物半導体素子のp電極であつて、

前記p電極は、A g及び/またはP tの金属電極が100オングストローム以下の厚みのN i金属領域を介してp型窒化ガリウム系化合物半導体層と接続し、且つ、前記半導体の発光ピーク波長における反射率が30%以上であることを特徴とする、窒化ガリウム系化合物半導体発光素子のp電極。

【請求項2】 前記A g及び/またはP tの金属電極は、N i金属領域と合金化されており、前記p型窒化ガリウム系化合物半導体層に近づくにしたがってA g及び/またはP tの含有量が少なくなっていることを特徴とする、請求項1に記載の窒化ガリウム系化合物半導体発光素子のp電極。

【請求項3】 前記p電極の最表面側には、A u層がT i層またはN i層を介して設けられていることを特徴とする、請求項1または請求項2に記載の窒化ガリウム系化合物半導体発光素子のp電極。

【請求項4】 請求項1から請求項3のいずれかに記載のp電極を、p型窒化ガリウム系化合物半導体層の露全面に形成したことを特徴とするフリップチップタイプの窒化ガリウム系化合物半導体発光素子。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】 本発明は、青色発光ダイオード、青色発光レーザダイオード等に用いることのできる窒化ガリウム系化合物半導体用の電極に関するもので、特に透光性基板側から光を出射するいわゆるフリップチップ型構造の場合に好適な電極に関するものである。

【0002】

【従来の技術】 近年、窒化ガリウム系化合物半導体[G a_x A l_{1-x}]、[I n_y N_{1-y}]（但し0≤x≤1、0≤y≤1）は、青色発光素子への応用がなされている。この窒化ガリウム系化合物半導体発光素子は、通常、サファイアよりもなる基板の上に一般式がG a_x A l_{1-x}、[I n_y N_{1-y}]（但し0≤x≤1、0≤y≤1）で表される窒化ガリウム系化合物半導体のエビタキシャル層を、MOCVD装置等を用いてn型層、p型層を積層成長させることによって得られ、その後、エッチングを行なって、n型電極およびp型電極を交互にn型層、p型層上に形成する。n型電極としては、例えば特開平7-45867号に記載されているT iを含有するオーミック電極が用いられ、p型電極としては、例えば特開平6-275868号、特開平5-291621号に記載されている金とN iおよび/またはC rを含む合

金が用いられている。

【0003】 図5に符号90で示すものは、上記した従来の窒化ガリウム系化合物半導体素子90を示すもので、A 1 G a N / I n G a N / A 1 G a N 系の青色発光素子である。このような窒化ガリウム系化合物半導体素子90は、例えば以下のような工程を経て製造される。

【0004】 (1) MOCVD装置内にサファイア基板91を配置し、温度約1050°Cにてサファイア基板91の表面処理を行なった後、基板温度を約510°Cまで下げて薄膜層のA 1 NまたはG a Nよりなるバッファーレ92を成長させる。

(2) 基板温度を約1020°Cとしてn型のG a N層93、n型A 1 G a N下部クラッド層94を成長させる。納めて基板温度を約800°Cとしてノンドープn G a N系活性層95を約100~500オングストロームの厚さに成長し、次に基板温度を約1020°Cとしてp型のA 1 G a N上部クラッド層96を成長させ、同温度にてp型G a Nキャップ層97を成長させる。

(3) ドライエッチング装置に移しn型のG a N層93が露出するまで一部のエッチングを行う。続いてp型G a Nキャップ層97の上にp電極98を、n型のG a N層93の露出面にn電極99をそれぞれ蒸着する。

【0005】

【発明が解決しようとする課題】 ところで、上述した従来の窒化ガリウム系化合物半導体素子90は、同一側にp電極98およびn電極99が存在し、p電極98側から光を取出す構造のため、p電極98として透光性電極を採用している（特開平6-314822号等参照）。その場合、p電極を與えたオーミック接続が得られるようになると共に低抵抗な透光性電極とする目的があるため、上述した金属材料を薄層に形成することが提案されている。しかし、その場合には透光性電極を金属層にて形成しているため、該電極で反射もしくは吸収される光が存在し、発光した光を効率よく外部に取出しているものではなかった。

【0006】 そこで、いわゆるフリップチップと称される構造を用いて、透光性のサファイア基板91側から光を取出す手段が注目されている。フリップチップタイプの場合には、上述した窒化ガリウム系化合物半導体素子90と同一の素子構造であって、同一面側に設けたp電極98およびn電極99に通電して発光した光が透光性のサファイア基板91側を通って外部に出射するため、p電極98により遮られることなく、高い外部取出し効率が期待される。

【0007】 しかしながら、上述した電極材料を用いた場合には、電極による反射率が低く、高い外部取出し効率が得られなかつた。例えば、上述したp電極98としてN iを100オングストロームの厚みで形成した後にA uを2500オングストローム形成させて合金化処理を施したp電極を用いた場合には、図5のような反射特性

を示し、発光ピーク波長である470nmでの反射率は約2.0%程度であり、外部取出し効率の高いフリップチップタイプの窒化ガリウム系化合物半導体素子を得ることに困難である。

【0008】本発明は、以上の点から、高い外部取出し効率を得るようになると共に、オーミック特性に優れた窒化ガリウム系化合物半導体素子の電極材料を提供することを目的としている。

【0009】

【課題を解決するための手段】上記目的は、本発明の実施態様によれば、透光性基板上にp型層が表面側となるようにして窒化ガリウム系化合物半導体をエピタキシャル成長し、該半導体の前記p型層間にp電極とn電極を配設して透光性基板面から光を取出すフリップチップタイプの窒化ガリウム系化合物半導体素子のp電極であって、p電極をA g及び/またはP tの金属電極が1.0オングストローム以下の厚みのN i金属領域8aを介してA g金属電極8bとp型窒化ガリウム系化合物半導体層7とを接触させた場合には、従来のN i-A u電極に比べて約3.5倍の高い反射率を示し、該p電極8を設けた半導体発光素子は従来のN i-A u電極を用いた素子に比べて約3倍の発光出力が得られる。同じく、厚みが1.0オングストローム以下の厚みのN i金属領域8aを介してP t金属電極8bとp型窒化ガリウム系化合物半導体層7とを接触させた場合には、約2.5倍の反射率と約2倍の発光出力が得られる。

【0010】この態様では、p電極の反射率を高めることができる、フリップチップタイプの窒化ガリウム系化合物半導体素子の外部取出し効率を大幅に向上させることができる。

【0011】

【発明の実施の形態】以下、この発明の好適な実施形態を図1から図4を参照しながら、詳細に説明する。尚、以下に述べる実施形態は、本発明の好適な具体例であるから、技術的におまじない種々の限定が付されているが、本発明の範囲は、以下の説明において特に本発明を限定する旨の記載がない限り、これらとの態様に限られるものではない。

【0012】図1は、本発明により製造されたフリップチップタイプの窒化ガリウム系化合物半導体発光素子10を、外部給電端子12を設けた基板13に導電性材料11で取付けた状態を示しており、図2はp電極8の一例を拡大して示している。また、該窒化ガリウム系化合物半導体発光素子10は、サファイアよりも基板1の上に一般式がG a_xAl_{1-x}N_yAl_{1-y}N_z（但し0≤x≤1, 0≤y≤1）で表される窒化ガリウム系化合物半導体のエピタキシャル層を、MOCVD装置等を用いて積層成長して、A lG aN/InG aN/G aN系の素子構造とした、青色発光素子の場合について示している。

【0013】サファイア基板1上にG aNよりなるバッファーレ1、n型のG aN層2、ノンドープInG aN系層5、p型のA lG aN系層6、p型G aNキャップ層7を順に成長させており、p型G aNキャップ層7の上にp電極8を、n型のG aN層9のエッティングによる露出面にn電極9をそれぞれ形成している。

【0014】本発明においては、p型G aNキャップ層と接触するp電極8を反射率が高く、且つオーミック特性に優れた電極材料としている点が従来と異なる。具体的には、p電極8として厚みが1.0オングストローム以下の厚みのN i金属領域8aを介してA g金属電極8bとp型窒化ガリウム系化合物半導体層7とを接触させた場合には、従来のN i-A u電極に比べて約3.5倍の高い反射率を示し、該p電極8を設けた半導体発光素子は従来のN i-A u電極を用いた素子に比べて約3倍の発光出力が得られる。同じく、厚みが1.0オングストローム以下の厚みのN i金属領域8aを介してP t金属電極8bとp型窒化ガリウム系化合物半導体層7とを接触させた場合には、約2.5倍の反射率と約2倍の発光出力が得られる。

【0015】N i金属領域8aの厚みを3～1.0オングストロームとし、A gもしくはP t金属領域8bの厚みを2.500オングストローム以上とすると、N i金属領域8aの反射成分が占める割合が低くなると同時に、A g等による反射成分の割合が高くなって、最も効果的な反射オーミック電極が得られる。N i金属領域の厚みをそれよりも厚くして形成するとN iによる反射成分が増加し、反射率が低下してくるため、N i金属領域8aの厚みが1.0オングストロームを超えるたまでは実用的ではない。さらに、N i金属領域8aが存在しないとp電極8が剥がれる問題が発生し易くなるので、5～1.0オングストロームの厚みのN i金属領域を設けることが最適である。

【0016】また、A gもしくはP t金属領域8bの厚さは、5.000オングストロームよりも薄くすると、透過量が増えて良好な反射膜とならなくなってくるため、少なくとも1.000オングストローム以上、好ましくは2.500オングストローム以上厚さとするといい。

【0017】以下、本発明の該窒化ガリウム系化合物半導体素子10について、その製造方法に沿って具体的な実施例について説明する。

【0018】（実施例1）サファイア基板1を用意し、MOCVD装置内にセットする。基板温度を約1050°Cとしてサファイア基板1の表面処理を行なった後、基板温度を約510°CとしてG aNよりなるバッファー層2を成長させる。続いて、基板温度を約1020°Cとしてn型のG aN層3およびn型G aN下部クラッド層4を合わせて20000オングストローム、基板温度を約800°CとしてノンドープInG aN系活性層5を約200オングストローム、基板温度を約1020°Cとしてp型のA lG aN上部クラッド層6を1000オングストローム成長させ、最後に同温度にてp型G aNキャップ層7を2500オングストローム成長させる。

【0019】窒化ガリウム系半導体のエピタキシャル層を成長させた基板1をドライエッティング装置に移し、一部分をn型のG aN層3が露出するまでエッティングを行

う。次にエッチングにより露出させたn型のGaN層3の表面に、チタン(Ti)およびアルミニウム(A1)を膜厚モニター層でそれぞれ250オングストローム、10000オングストロームの厚みとなるように連続して蒸着してn電極9を形成する。

【0020】同様に窒化ガリウム系半導体エピタキシャル層の、前記したn型GaN層3を露出させた部分以外の表面側p型GaNキャップ層7のほぼ全表面にp電極8を形成する。p電極8は、p型GaNキャップ層7側から順にニッケル(Ni)および銀(Ag)を膜厚モニター層でそれぞれ10オングストローム、2500オングストロームとなるようにして蒸着した。その後、窒素雰囲気内にて500～600°Cの温度で約60秒間、素子1全体を加熱してp電極8を合金化してオーミック電極とした。また、p電極については反射率測定用のサファイア基板1上にも同時に作成した。

【0021】(実施例2) サファイア基板1の上に、実施例1と同一条件にて窒化ガリウム系化合物半導体エピタキシャル成長させ、その一部をエッチングしてn型GaN層3を露出させ、Ti-A1からなるn電極9およびNi-Agからなるp電極8を形成し、熱処理を施した。さらに、このp電極8の上に外部電極端子12との接続性を向上させるための上部p電極層81としてチタン(Ti)層81aを400オングストローム、金(Au)層81bを7000オングストロームの厚さで蒸着した。図2はこのようにして作成した窒化ガリウム系半導体素子1のp電極8を拡大して示すものである。なお、符号8aはニッケル層、8bはAg層を示すが、熱処理により合金化を図っているので、その境界部を中心に合金領域が形成されている。

【0022】(実施例3) p電極8としてNi-Agではなく、p型層7側から順にニッケル(Ni)を10オングストローム、白金(Pt)を2500オングストロームとなるようにして蒸着した以外は、実施例1と同一条件にて窒化ガリウム系半導体発光素子10を作成した。

【0023】(比較例) p電極98としてp型層87個から順にニッケル(Ni)を140オングストローム、金(Au)を7000オングストロームとなるようにして蒸着した以外は、実施例1と同一条件にて図1に示す窒化ガリウム系半導体発光素子10と同一構成の素子を作成した。

【0024】実施例1～3および比較例にて作成したp電極材料の反射率を測定した。各々の電極材料はサファイア基板上にp電極形成時に同時に蒸着した測定用試料を用い、サファイア基板側から金属電極材料に向かって測定光を入射させて反射率を測定した。図3は、島津製作所製のUV-3100分光器を用い、サファイア基板のみの反射率を差し引いた電極材料の反射率の測定結果を示す。窒化ガリウム系半導体発光素子10の発光ピー

ク波長470nmにおいて、比較例の場合には約20%であるのに対し、実施例1および実施例2の場合には約70.9%、実施例3の場合で約50.9%であり、それぞれ約3.5倍、約2.5倍の大幅な反射率の向上が見られた。

【0025】また、実施例1～3および比較例にて作成したp電極のオーミック特性についても測定した。図4に電流電圧特性を示す。図4(a)は実施例1および実施例2の場合、図4(b)は実施例3の場合、図4

10 (c)は比較例の場合である。この図に示すようにいずれの材料でもオーミック接觸が得られ、実施例1および実施例2の場合がもっとも良好なオーミック接觸を示している。

【0026】さらに、窒化ガリウム系半導体発光素子をフリップチップタイプにて接続して、樹脂封止を行わずに横分球内にて同一条件で発光させて光出力を測定したところ、実施例1および実施例2の素子は、比較例の素子に対し約3倍の出力が得られた。

【0027】また、実施例1に比べ実施例2のp電極構造とした素子の方が、外部給電端子12とフリップチップ接続した際の寿命特性が良好であった。これは、導電性材料11と接する側の表面がAuを主成分とするp電極表面となっていることで、導電性材料11との密着性が向上したものと思われる。特に、導電性材料11として半田を主成分とするものを用いた場合に、Au層を表面に設けることで顯著に寿命特性が向上する。

【0028】なお、実施例2においては上部p電極層81としてチタン(Ti)層81aおよび金(Au)層81bを積層し、熱処理を施していない。Ni、Ag、Ti

30 i、Auを連続して積層した後に熱処理を実施して合金化させるものとしても良いが、その場合には反射率が粗面化する傾向があり、反射率が5%程度低下する場合があった。したがって、Auを最表面とする上部p電極層81を設ける場合には、p型窒化ガリウム系半導体発光層と接するp電極部の熱処理を行なった後に、形成することが好ましい。また、上部p電極層81は最表面層をAuとし、TiのかわりにNiを用いてp電極8の上に形成するものでもよく、Au上部電極層81bの厚みを5000オングストローム以上、TiもしくはNi上部電極層81aの厚みを1000オングストローム以下とすることが好ましい。

【0029】したがって、p型窒化ガリウム系半導体層側から表面側にかけての層厚方向のp電極の構成は、Ni成分についてはp型窒化ガリウム系半導体層側が増加すると共に、その上にAgもしくはPt成分が存在するものとし、更に好ましくは、最表面をAuとし、その下にTiもしくはNi領域とした上部電極層を設けることが好ましい。

【0030】また、一般的にはNi-Au電極に比べNi-Ag電極の方が仕事間数が低く、障壁が高いと考え

られる。しかし、実施例1と同一条件下で層層形成したNi-Au電極を窒素雰囲気下において、300～800°Cの温度範囲で、熱処理時間を10秒～120秒の範囲に変化させて接触抵抗を測定したところ、500°Cで30秒以上、600°Cで20秒以上、700°Cで10秒以上の場合においてオーミック接触が得られ、500°Cで60秒の熱処理を施した場合に $3.42 \times 10^{-3} \Omega / \text{cm}^2$ という低い接触抵抗が得られた。この原因は定かではないが、一般的なNi-Au電極の場合の $10^{-3} \sim 10^{-2} \Omega / \text{cm}^2$ もよりも約1桁低い値もしくは同等の接触抵抗を示し、発光素子のVf低下に寄与する。したがって、低い接触抵抗率を得るために500～600°Cで45～90秒の熱処理を施すことが好ましい。

【0031】上述した実施形態においては、AlGaN/ InGaN/GaN 系の粒子構造とした窒化ガリウム系化合物半導体発光素子を示しているが、これに限らず、SQW、MQW等の構造、他の組成のものであってもよい。また、サファイア基板1ではなく、他の透光性基板を用いるものであってもよい。

【0032】

【発明の効果】以上述べたように、本発明によれば、フリップチップタイプの窒化ガリウム系半導体発光素子のp電極を、良好なオーミック特性と高い反射率を満足する電極とすることができる。これにより、フリップチップタイプの窒化ガリウム系半導体発光素子の光取出し効率を向上させ、明るい発光素子を得ることができる。また、電極面積を大きくとることができため、放熱特性に優れた素子とすることもできる。

* 【図面の簡単な説明】

【図1】本発明のフリップチップタイプの窒化ガリウム系化合物半導体素子を説明するための概略断面図である。

【図2】本発明のp電極の一実施例を説明するための要部断面図である。

【図3】本発明のp電極の反射率スペクトルを示す説明図である。

【図4】本発明のp電極の電流電圧特性を示す説明図である。

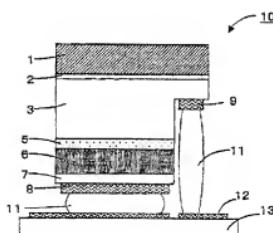
【図5】従来の窒化ガリウム系化合物半導体を説明するための概略断面図である。

【図6】従来のp電極の反射率スペクトルを示す説明図である。

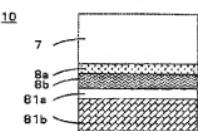
【符号の説明】

1、91	サファイア基板
2、92	バッファー層
3、93	n型のGaN層
5、95	nドープInGaN系層
20	
6、96	p型のAlGaN系層
7、97	p型GaNキャップ層
8、98	p電極
9、99	n電極
10、90	窒化ガリウム系化合物半導体発光素子
11	導電性材料
12	外部給電端子
13	基体
*	上部p電極層
81	

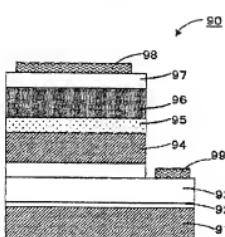
【図1】



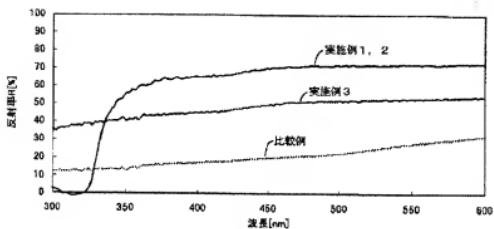
【図2】



【図5】



【図3】

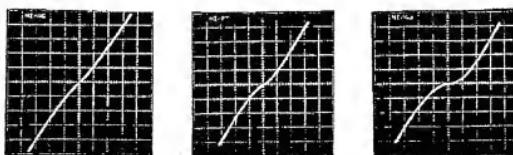


【図4】

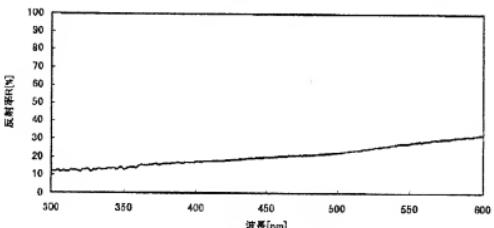
(a)

(b)

(c)



【図6】



フロントページの続き

■ ターム(参考) SF041 AA03 AA21 CA13 CA34 CA40
CA65 CA73 CA74 CA83 CA92
CA98 DA09
SF073 AB16 CA07 CB05 CB22 CB23
DA05 DA16 DA30 DA35 EA29
FA30